

Intel 和 Micron 獲得 2011 年度快閃記憶體峰會最具創意快閃記憶體大獎

20 納米 (nm) NAND 快閃記憶體處理技術處於業界領先地位

加州聖克拉市和愛達荷州博伊西市，2011 年 8 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE 消息）— Intel 公司（Nasdaq:INTC）和 Micron Technology, Inc.（Nasdaq:MU）於 2011 年度快閃記憶體峰會獲頒最具創意快閃記憶體大獎。兩家公司所擁有的 20 納米 NAND 快閃記憶體處理技術於業界享有領先的地位。

由 Intel 和 Micron 創製的 20 納米 8GB NAND 設備以最小的形態提供最大的容量。這項創新的產品是由 Intel 和 Micron 合資創立的 IM 快閃記憶體技術公司所生產，在 NAND 處理和技術設計方面取得突破性的進展，進一步鞏固公司在光刻印刷行業的領先地位。

將 NAND 光刻技術縮小至此科技的點節，是目前最具成本效益的 NAND 輸出增加方法，比現有科技提供高出 50% 的 GB 容量。全新的 20 納米處理技術亦有助公司達成低價且資訊全球通行的雙重目標。

「全功能智慧手機和平板電腦需要儲存大量的資訊，增加市場對 NAND 快閃記憶體技術的需求，特別是容量高、體積小的設計。」Micron 公司 NAND 解決方案小組副總裁 Glen Hawk 表示：「Micron 與 Intel 合作研發的這項技術領先業界，我們亦引以為傲。能夠在快閃記憶體技術峰會獲得肯定是我們莫大的榮幸。」

「NAND 矽處理高水平的創新技術能夠帶來固態驅動等的嶄新終端解決方案，奠定了快閃記憶體的發展。」Intel 非可變性記憶解決方案小組副總裁兼總經理 Tom Rampone 表示：「我們很高興能夠獲頒這項殊榮。這不單是對我們技術創新方面的肯定，同時也是對 Intel 和 Micron 之間成功合作的肯定。」

另外，與現有的 25 納米 8GB NAND 設備相比，全新的 20 納米 8GB 設備的尺寸只有 118 平方毫米，節省 30% 到 40% 的電路板空間（具體取決於封裝類型）。快閃記憶體尺寸的減少能夠提升系統性能，因為平板電腦和智慧手機的終端產品能夠利用騰出來的空間改善性能，例如增加電池容量、增大螢幕面積或者添加一個晶片以帶來新功能等。

快閃記憶體峰會是唯一一個致力於快閃記憶體技術發展和應用的會議，為系統設計師、分析人員、硬體和軟體工程師、產品銷售人員和行銷傳播專家、以及工程和市場經理提供了交流的平台。它籌辦各類論壇、半日課程、報告和討論會、專家會議等。其關注的主題包括艱澀的環境、手提電腦、企業儲存系統應用程式、消費品、性能、產品設計、緩存方法、設計方案、軟件、創新技術、市場研究、測試和可靠性以及安全性等。快閃記憶體峰會也展示最新產品及頒獎。更多資訊，請訪問：

www.flashmemorysummit.com。

Intel (Nasdaq:INTC) 是計算創新領域的全球領先廠商。Intel 公司設計和構建關鍵技術，為全球的計算設備奠定基礎。更多關於 Intel 的資訊，請瀏覽：
newsroom.intel.com 和 blogs.intel.com。

Micron Technology, Inc. 是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一，透過全球各地的營運，Micron 製造並銷售 DRAM、NAND 和 NOR 記憶體、其他記憶體科技、封裝解決方案和半導體系統，用於尖端電腦、消費者、網路以及內建和行動產品。Micron 普通股於美國 NASDAQ 股市交易，代碼為 MU。關於 Micron Technology, Inc. 的進一步詳情，請前往公司網站：www.micron.com

若想取得 Micron Technology, Inc. 的標誌，請瀏覽
<http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

(C)2011 Micron Technology, Inc. 和 Intel 公司。版權所有。如果資訊有變，恕不另行通知。

Micron 和 Micron 商標屬 Micron Technology, Inc. 所有。Intel 商標屬 Intel 公司或其位於美國或其他國家的子公司所有。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

聯絡人：Deb Paquin
Intel NVM Solutions Group
916-984-1921
debpaquin@strategiccom.biz

Daniel Francisco
Micron Technology, Inc.
208-368-5584
dfrancisco@micron.com